

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## 8ビット CMOS PROM

1Mワード×8ビット (バイト・モード) / 512Kワード×16ビット (ワード・モード)

μPD27C8000は8,388,608ビットの電氣的プログラム可能なリード・オンリー・メモリ (ワン・タイムPROM) です。ワード構成はバイト・モード (1,048,576ワード×8ビット) とワード・モード (524,288ワード×16ビット) の切り替えができます。

パッケージは、42ピン・プラスチックDIP、44ピン・プラスチックSOPを用意しています。

## 特 徴

- ・ワード構成
  - 1,048,576ワード×8ビット (バイト・モード)
  - 524,288ワード×16ビット (ワード・モード)
- ・アクセス時間 150 ns (MAX.)
- ・低消費電流
  - 動作時 : 50 mA (MAX.)
  - スタンバイ時: 100 μA (MAX.) (CMOSレベル入力)
- ・高速プログラム・モード
- ・マスクROM μPD23C8000シリーズとピン・コンパチブル

★

## オーダ情報

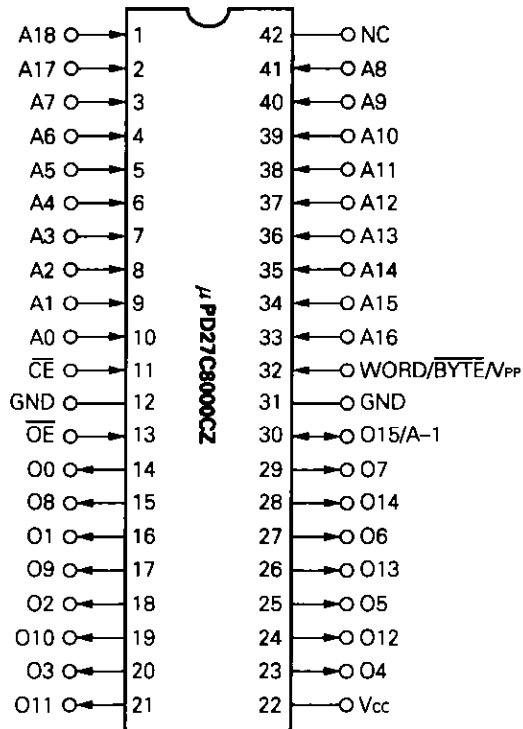
オーダ名称	アクセス時間 ns (MAX.)	パッケージ	機能
μPD27C8000CZ-15	150	42ピン・プラスチックDIP (600 mil)	ワン・タイムPROM
μPD27C8000CZ-17	170		
μPD27C8000GX-15	150	44ピン・プラスチックSOP (600 mil)	
μPD27C8000GX-17	170		

★

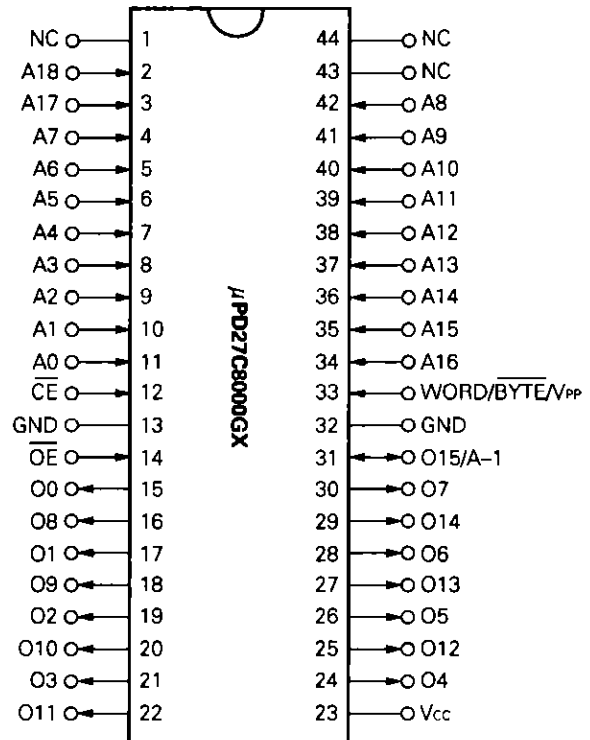
本資料の内容は、後日変更する場合があります。

★ 端子接続図 (Marking Side)

42-pin Plastic DIP (600 mil)



44-pin Plastic SOP (600 mil)

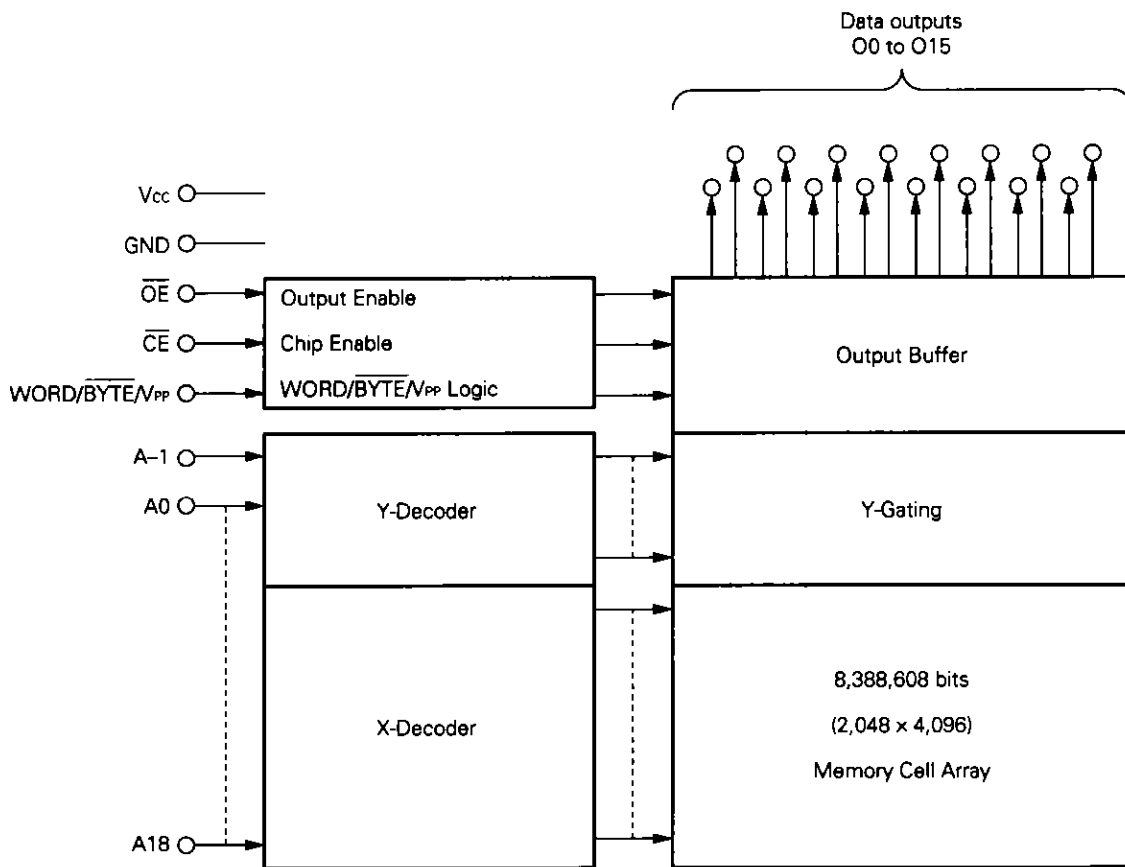


- A0-A18 : アドレス入力
- O0-O14<sup>※1</sup> : データ出力 (データ入力)
- O15/A-1 : データ出力15 (データ入力15) (ワード・モード) / LSBアドレス入力 (バイト・モード)
- WORD/ $\overline{\text{BYTE}}$ /V<sub>PP</sub> : モード選択 / プログラム電源
- $\overline{\text{CE}}$  : チップ・イネーブル入力
- $\overline{\text{OE}}$  : アウトプット・イネーブル入力
- V<sub>CC</sub> : 電源
- GND : グランド
- NC<sup>※2</sup> : ノー・コネクション

注1. バイト・モード時はO8-O14はHi-Zとなります (開放状態で使用してください)。

2. この端子は、チップ内部に接続されておらず、電圧が加わっても問題ありません。

ブロック図



動作モード

μPD27C8000は7種類の動作モード選択ができます。

リード、出力ディスエーブル、スタンバイのモードでは、Vcc = 5.0 Vに設定してください。

プログラム、プログラム・ベリファイ、プログラム・インヒビットのモードではVcc = 6.5 Vに設定してください。

$\overline{CE}$ 、 $\overline{OE}$ 、 $\overline{WORD/BYTE/VP}$ のコントロール端子により各モードの設定をします。

動作モード

端子名 モード	$\overline{CE}$	$\overline{OE}$	$\overline{WORD/BYTE/VP}$	Vcc	O0 - O7	O8 - O14	O15/A - 1
リード (ワード・モード)	L	L	H	5.0 V	データ出力	データ出力	データ出力
リード (バイト・モード)	L	L	L		データ出力	Hi-Z	LSBアドレス入力
出力ディスエーブル	L	H	X		Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z
スタンバイ	H	X	X		Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z
プログラム	L	H	12.5 V	6.5 V	データ入力	データ入力	データ入力
プログラム・ベリファイ	H	L			データ出力	データ出力	データ出力
プログラム・インヒビット	H	H			Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z
	L	L					

備考 X：HまたはL

HはTTLレベルのハイ・レベル入力電圧、LはTTLレベルのロウ・レベル入力電圧を示します。

1. リード・モード (ワード・モード)

$\overline{WORD/BYTE/VP} = V_{IH}$ ,  $\overline{CE} = V_{IL}$ ,  $\overline{OE} = V_{IL}$ にすることによりワード・モードのリード・モードが設定されます。出力データは、アドレスがセットされてから $t_{acc}$ の時間経過後、または $\overline{CE}$ の立ち下がりから $t_{CE}$ の時間経過後、または $\overline{OE}$ の立ち下がりから $t_{OE}$ の時間経過後、データ出力端子O0 - O15よりデータ・バスに出力されます。

2. リード・モード (バイト・モード)

$\overline{WORD/BYTE/VP} = V_{IL}$ ,  $\overline{CE} = V_{IL}$ ,  $\overline{OE} = V_{IL}$ にすることによりバイト・モードのリード・モードが設定されます。出力データは、アドレスがセットされてから $t_{acc}$ の時間経過後、または $\overline{CE}$ の立ち下がりから $t_{CE}$ の時間経過後、または $\overline{OE}$ の立ち下がりから $t_{OE}$ の時間経過後、データ出力端子O0 - O7よりデータ・バスに出力されます。なおO8 - O14はHi-Z、O15/A - 1はLSBアドレス入力となります。

3. 出力ディスエーブル・モード

$\overline{OE} = V_{IH}$ にすることによりO0 - O15端子はHi-Zとなり、データの出力ができません。したがってデータ・バスに複数のμPD27C8000を接続した場合、 $\overline{OE}$ をコントロールすることで任意の1個のデバイスよりデータを読み出すことができます。

4. スタンバイ・モード

$\overline{CE} = V_{IH}$ にすることによりスタンバイ・モードとなり、Vcc電流は50 mAから1 mAまで減少します。スタンバイ電流は $\overline{CE}$ のレベルにより異なり、 $\overline{CE} = V_{IH}$  (MIN.) では1 mA (MAX.) ( $I_{CCS1}$ )、 $\overline{CE} \geq V_{CC} - 0.2$  Vでは100 μA (MAX.) ( $I_{CCS2}$ ) と大幅に低減できます。このモードでは、 $\overline{OE}$ の状態に関係なくO0 - O15はHi-Zとなります。

## 5. プログラム・モード

$\mu$ PD27C8000は、全ビット“1”の状態出荷され、プログラムを行うことにより任意のビットが“0”に変化します。プログラムは $V_{CC} = 6.5\text{ V}$ 、 $\text{WORD}/\text{BYTE}/V_{PP} = 12.5\text{ V}$ および初期アドレスの設定により開始されます。プログラムするデータの内容は16ビット（1ワード）でデータ・バスより直接入力できます。

プログラムは、初期アドレスに対して、 $\overline{\text{OE}} = V_{IH}$ の状態では $\overline{\text{CE}}$ 端子に $50\ \mu\text{s}$ のプログラム・パルス（アクティブ・ロウ）を加え、ただちに、 $\overline{\text{CE}} = V_{IH}$ 、 $\overline{\text{OE}} = V_{IL}$ にしてプログラム・ベリファイを実行することにより行われます。1回のプログラム・パルスでプログラムできない場合は、 $X$ 回（ $X \leq 10$ ）のプログラムとプログラム・ベリファイを繰り返し実行し、1ワードのプログラムを確認後、1ワードのプログラムが完了します。1ワードのプログラムが完了すると、アドレスをインクリメントし最終アドレスまで同様のシーケンスを繰り返し実行します。

図1にプログラム・モード・フロー・チャートを示します。

備考 バイト・モードでのプログラムはできません。

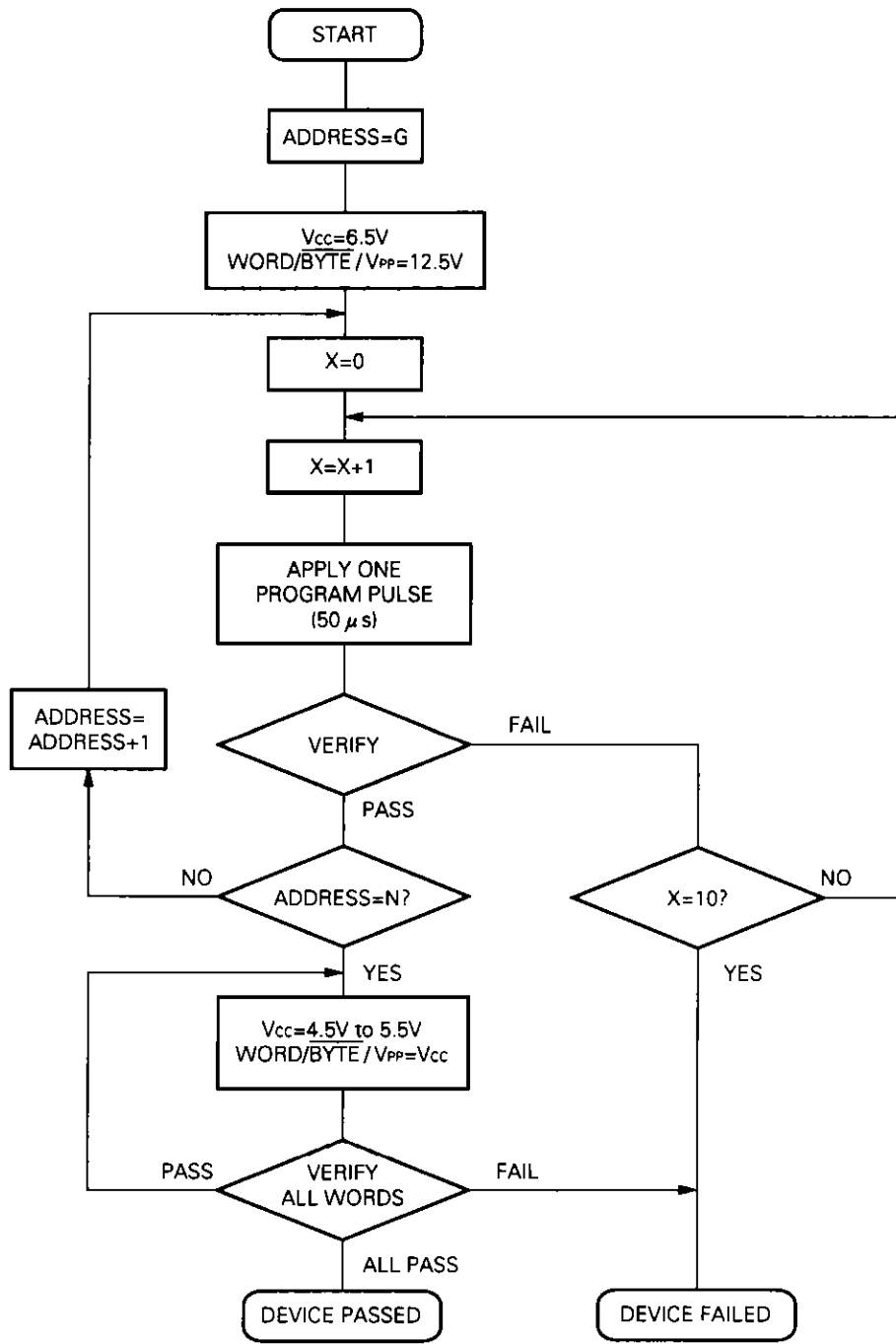
## 6. プログラム・ベリファイ・モード

このモードは、プログラムの確認を行うモードです。プログラムを行ったあと、そのビットに正しく書き込まれたかどうかをこのモードで確認してください。プログラム・ベリファイは $\overline{\text{CE}} = V_{IH}$ 、 $\overline{\text{OE}} = V_{IL}$ の状態で行えます。

## 7. プログラム・インヒビット・モード

このモードは、複数の $\mu$ PD27C8000の $\overline{\text{OE}}$ 、 $\overline{\text{WORD}}/\overline{\text{BYTE}}/V_{PP}$ 、 $\text{O0} - \text{O15}$ が並列に接続されていて、そのうちの1個のデバイスにプログラムを行う際に使用します。プログラムを行うとき、他の $\mu$ PD27C8000の $\overline{\text{CE}}$ 端子を $V_{IH}$ にしておけば、それらのデバイスにはプログラムが行われません。

図1 プログラム・モード・フロー・チャート



G=FIRST ADDRESS  
N=LAST ADDRESS



電気的特性

絶対最大定格

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>		-0.6 ~ +7.0	V
電源電圧	WORD/ BYTE/V <sub>PP</sub>		-0.6 ~ +13.5	V
入力電圧	V <sub>i</sub>		-0.6 ~ +V <sub>CC</sub> + 0.3	V
	V <sub>i</sub>	アドレスA9	-0.6 ~ +13.5	
出力電圧	V <sub>o</sub>		-0.6 ~ +7.0	V
動作周囲温度	T <sub>A</sub>		-10 ~ +80	℃
保存温度	T <sub>stg</sub>		-55 ~ +125	℃

★

注意 各項目のうち1項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を越えると、製品の品質を損なう恐れがあります。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で、製品をご使用ください。

リード・オペレーション

推奨動作条件

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	4.5	5.0	5.5	V
ハイ・レベル入力電圧	V <sub>IH</sub>	2.0		V <sub>CC</sub> + 0.3	V
ロウ・レベル入力電圧	V <sub>IL</sub>	-0.3		+0.8	V
動作周囲温度	T <sub>A</sub>	0		70	℃

DC特性 (推奨動作条件による)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ハイ・レベル出力電圧	V <sub>OH1</sub>	I <sub>OH</sub> = -400 μA	2.4			V
	V <sub>OH2</sub>	I <sub>OH</sub> = -100 μA	V <sub>CC</sub> - 0.7			
ロウ・レベル出力電圧	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 2.1 mA			0.45	V
出力リーク電流	I <sub>LO</sub>	V <sub>OUT</sub> = 0 V ~ V <sub>CC</sub> , $\overline{OE} = V_{IH}$	-10		+10	μA
入力リーク電流	I <sub>LI</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 V ~ V <sub>CC</sub>	-10		+10	μA
WORD/ $\overline{BYTE}$ /V <sub>PP</sub> 電流	I <sub>PP</sub>	WORD/ $\overline{BYTE}$ /V <sub>PP</sub> = V <sub>CC</sub>		1	100	μA
V <sub>CC</sub> 電源電流	I <sub>CCA1</sub>	$\overline{CE} = V_{IL}$ , V <sub>IN</sub> = V <sub>IH</sub>			50	mA
	I <sub>CCA2</sub>	I <sub>OUT</sub> = 0 mA, 最小サイクル時間			50	
スタンバイ電源電流	I <sub>CCS1</sub>	$\overline{CE} = V_{IH}$ (MIN.)			1	mA
	I <sub>CCS2</sub>	$\overline{CE} \geq V_{CC} - 0.2$ V, V <sub>IN</sub> = 0 V ~ V <sub>CC</sub>		1	100	

備考 V<sub>CC</sub>の値は、デバイスが動作状態にあるときに実際に印加されている電圧値を示すものであり、電源電圧範囲内のすべての値を示すものではありません。

★ AC特性 (推奨動作条件による)

項目	略号	条件	μPD27C8000-15		μPD27C8000-17		単位
			MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
アドレス-データ出力遅延時間	t <sub>ACC</sub>	$\overline{CE} = \overline{OE} = V_{IL}$		150		170	ns
$\overline{CE}$ -データ出力遅延時間	t <sub>CE</sub>	$\overline{OE} = V_{IL}$		150		170	ns
$\overline{OE}$ -データ出力遅延時間	t <sub>OE</sub>	$\overline{CE} = V_{IL}$		70		70	ns
$\overline{OE}(\overline{CE})$ -データ出力フロート時間	t <sub>DF</sub>	$\overline{CE}(\overline{OE}) = V_{IL}$	0	55	0	55	ns
アドレス-出力保持時間	t <sub>OH</sub>	$\overline{CE} = \overline{OE} = V_{IL}$	0		0		ns
WORD/BYTE アクセス時間	t <sub>WB</sub>	$\overline{CE} = \overline{OE} = V_{IL}$		150		170	ns

備考 t<sub>DF</sub>は $\overline{CE}$ あるいは $\overline{OE}$ のどちらかがインアクティブになったときから出力がHi-Zになるまでの時間です。

AC特性試験条件

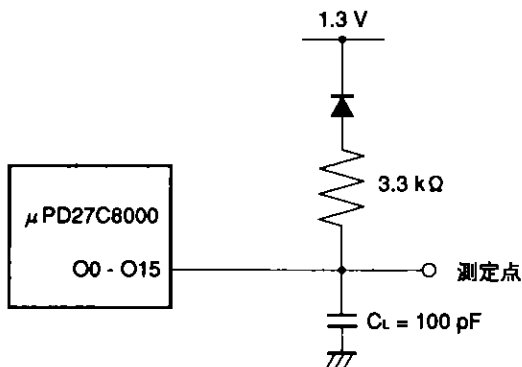
入力波形 (立ち上がり/立ち下がり時間 ≤ 20 ns)



出力波形



出力負荷

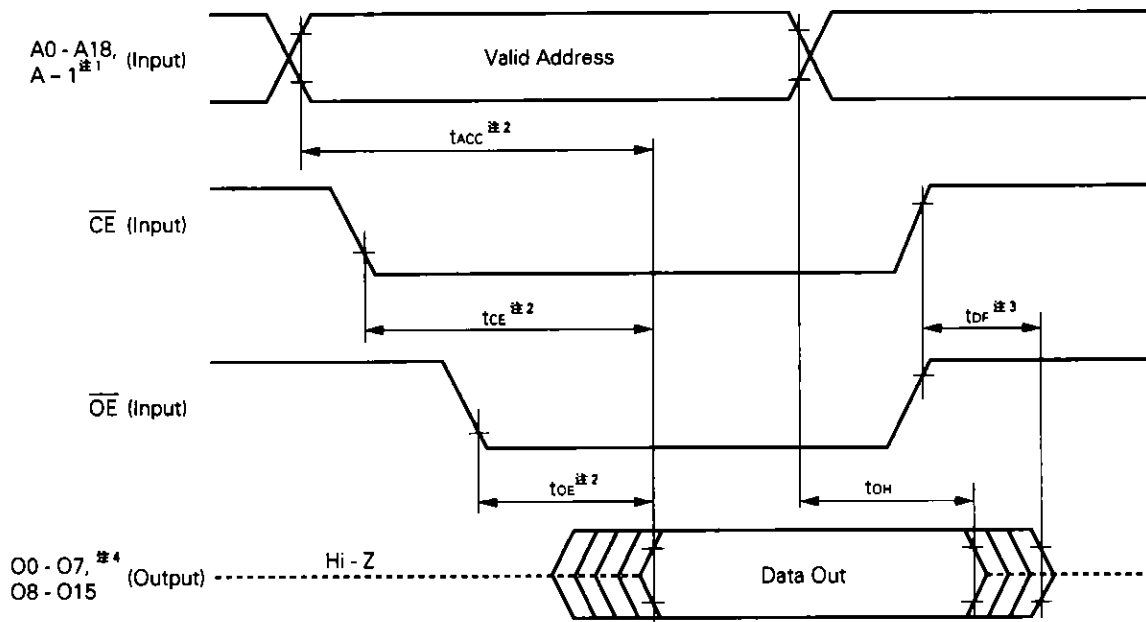


備考 CLは測定器のプロープと治具の容量、浮遊容量を含みます。

入出力容量 (T<sub>A</sub> = 25 °C, f = 1 MHz)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力容量	C <sub>i</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 V			14	pF
出力容量	C <sub>o</sub>	V <sub>OUT</sub> = 0 V			16	pF

リード・モード・タイミング・チャート



注1. ワード・モード時は、 $A - 1$ は015です。

2. アドレス・アクセス・リードを行う場合：

$\overline{CE}$ はアドレスが確定する以前にロウ・レベルにしてください。また、 $\overline{OE}$ はアドレスが確定してから  $t_{ACC} - t_{OE}$ 以前にロウ・レベルにしてください。

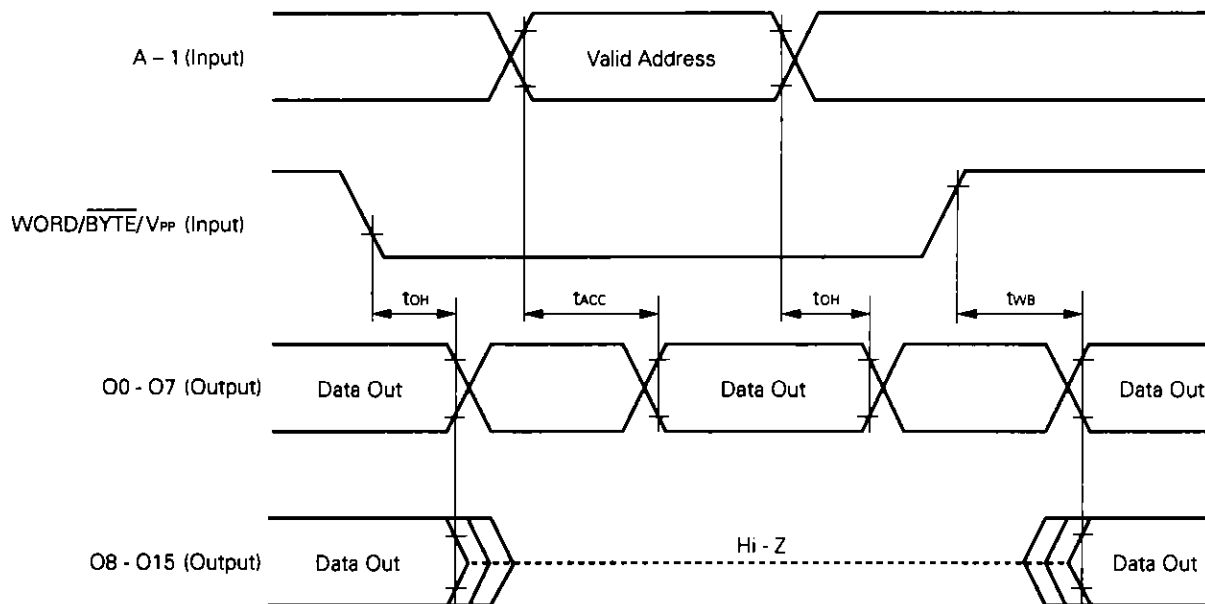
チップ・イネーブル・アクセス・リードを行う場合：

$\overline{CE}$ はアドレスが確定以後にロウ・レベルにしてください。また、 $\overline{OE}$ は $\overline{CE}$ が確定してから  $t_{CE} - t_{OE}$ 以前にロウ・レベルにしてください。

3.  $t_{DF}$ は $\overline{OE}$ あるいは $\overline{CE}$ が $V_{IH}$ となったときからの時間です。

4. バイト・モード時は、08 - 014は $Hi-Z$  (015は $A - 1$ ) です。

ワード・モード, バイト・モード切り替えタイミング・チャート



備考  $\overline{OE}$  and  $\overline{CE}$  : アクティブ状態

プログラム・オペレーション

DC特性 ( $T_A = 25 \pm 5^\circ C$ ,  $V_{CC} = 6.5 \pm 0.25 V$ ,  $WORD/BYTE/V_{PP} = 12.5 \pm 0.3 V$ )

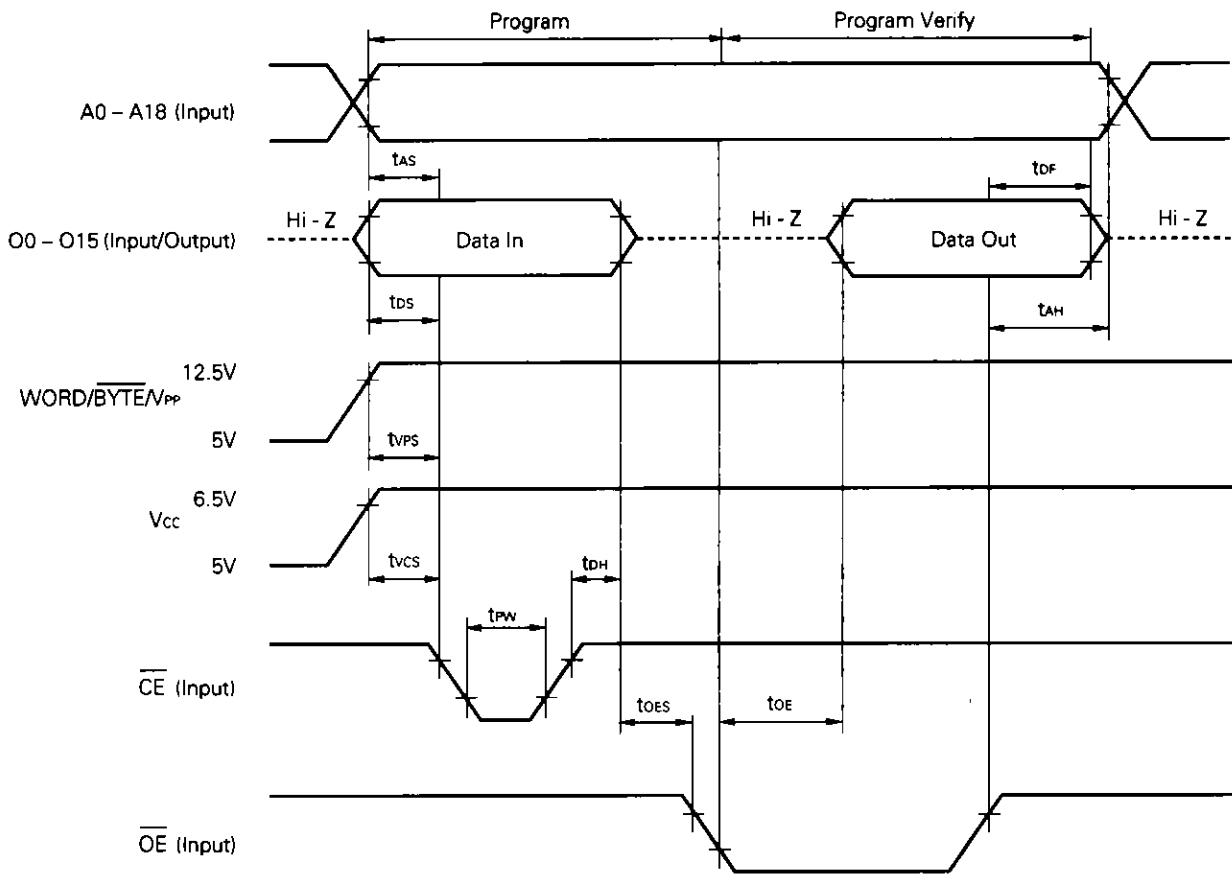
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ハイ・レベル入力電圧	$V_{IH}$		2.4		$V_{CC} + 0.3$	V
ロウ・レベル入力電圧	$V_{IL}$		-0.3		+0.8	V
入力リーク電流	$I_{LI}$	$V_{IN} = 0 V \sim V_{CC}$	-10		+10	μA
ハイ・レベル出力電圧	$V_{OH}$	$I_{OH} = -400 \mu A$	2.4			V
ロウ・レベル出力電圧	$V_{OL}$	$I_{OL} = 2.1 mA$			0.45	V
$V_{CC}$ 電源電流	$I_{CC}$				50	mA
$WORD/BYTE/V_{PP}$ 電流	$I_{PP}$	$\overline{CE} = V_{IL}, \overline{OE} = V_{IH}$			50	mA

AC特性 ( $T_A = 25 \pm 5^\circ C$ ,  $V_{CC} = 6.5 \pm 0.25 V$ ,  $WORD/BYTE/V_{PP} = 12.5 \pm 0.3 V$ )

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
アドレス・セット時間	$t_{AS}$		2			μs
データ入力セット時間	$t_{DS}$		2			μs
アドレス保持時間	$t_{AH}$		2			μs
データ入力保持時間	$t_{DH}$		2			μs
$\overline{OE}$ - データ出力フロート遅延時間	$t_{DF}$		0		130	ns
$WORD/BYTE/V_{PP}$ セット時間	$t_{VPS}$		2			μs
$V_{CC}$ セット時間	$t_{VCS}$		2			μs
プログラム・パルス幅	$t_{PW}$		47.5	50	52.5	μs
$\overline{OE}$ セット時間	$t_{OES}$		2			μs
$\overline{OE}$ - 有効データ遅延時間	$t_{OE}$				150	ns

備考 AC特性試験条件はリード・オペレーションの場合と同じです。

プログラム・モード・タイミング・チャート



- 注意 1. V<sub>CC</sub>はWORD/BYTE/V<sub>PP</sub>より前に印加し、WORD/BYTE/V<sub>PP</sub>のあとから切断するようにしてください。
2. WORD/BYTE/V<sub>PP</sub>はオーバシュートを含めて+13.5V以上にならないようにしてください。
3. WORD/BYTE/V<sub>PP</sub>に12.5Vが印加されている間に抜き差しした場合、信頼性上、悪影響を受ける可能性があります。

★ ワン・タイムPROMについて

ワン・タイムPROMは、その性質上一度のみの書き込みしかできないため、パッケージ組立後の全ビット書き込み試験を実施することができません。したがって書き込み後の良品率100%は保証しておりません。

UV EPROMなみの信頼性を重視される向きには、スクリーニングを推奨しています。

1. スクリーニング

- (1) PROMプログラマにより書き込み操作を行う。
- (2) 125℃、24 ± 4時間の高温保管を行う。
- (3) 読み出し確認を行い、不良品を除去する。

2. 特定ロットで多数の不具合が発生した場合

(1) 書き込み時の不具合

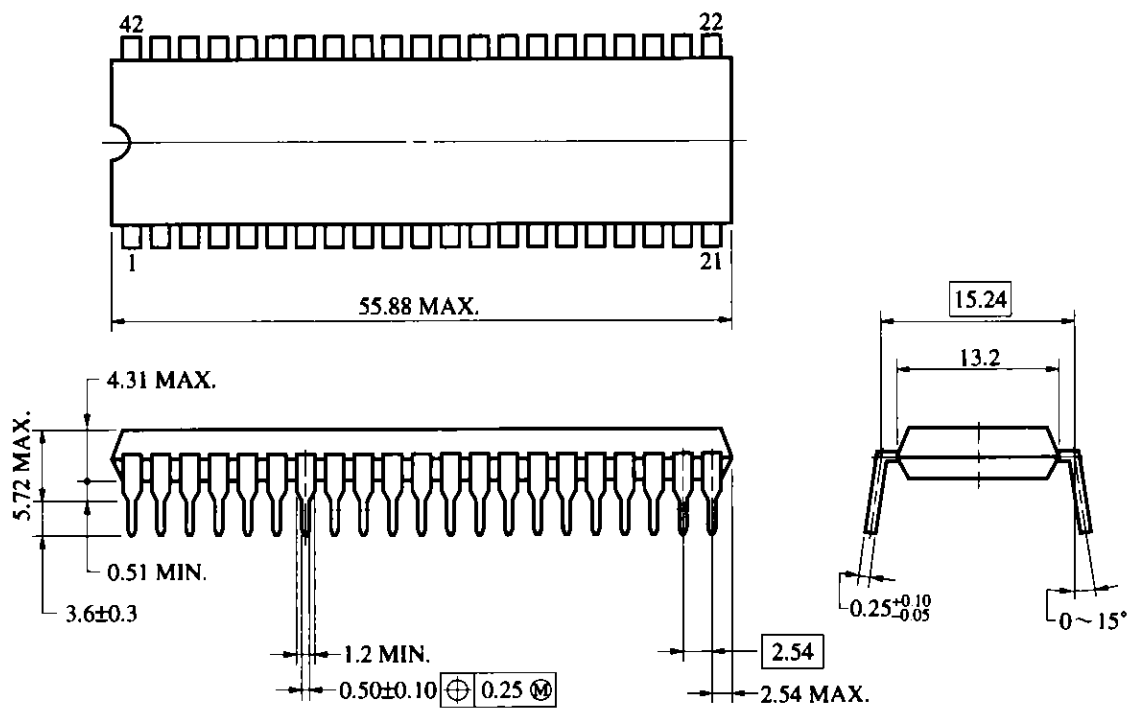
- ①まず次の事項を確認してください。
  - ・PROMプログラマやアダプタの接触不良はありませんか？
  - ・PROMプログラマやアダプタの電氣的異常はありませんか？
  - ・ご使用のPROMプログラマは当社の認定対象機種ですか？
- ②上記の異常が認められない場合、  
不具合の詳細を当社販売員にお知らせください。

(2) 書き込み後の不具合（お客様の製造工程や市場での不具合）

- ①PROMのデータ内容を確認してください。（プログラム・ベリファイ・モード参照）
  - ・ベリファイ（照合）結果が異常の場合  
PROMのデータ保持性能不良の可能性があります。
  - ・ベリファイ結果が正常の場合  
PROMのデータ保持性能不良以外の不具合の可能性があります。
- ②不具合の詳細とベリファイ結果を当社販売員にお知らせください。

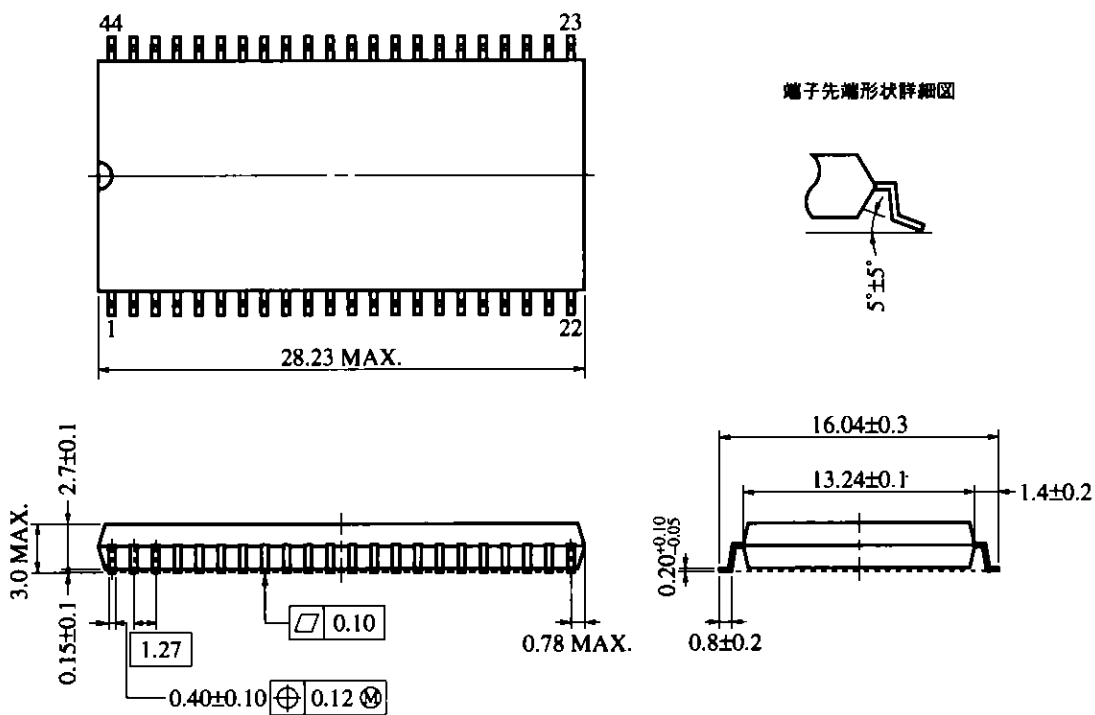
外形図

42ピン・プラスチック DIP (600 mil) 外形図 (単位: mm)

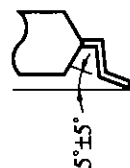


P42C-100-600A, B-1

44ピン・プラスチック SOP (600 mil) 外形図 (単位: mm)



端子先端形状詳細図



P44GX-50-600A-1

## ★ 半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」(IEI-616)を参照してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

## 表面実装タイプ

μPD27C8000GX：44ピン・プラスチックSOP（600 mil）

当社販売員にお問い合わせください。

## 挿入タイプ

μPD27C8000CZ：42ピン・プラスチックDIP（600 mil）

半田付け方式	半田付け条件
ウェーブ・ソルダーリング (端子のみ)	半田槽温度：260℃以下、時間：10秒以内
端子部分加熱	端子温度：300℃以下、時間：3秒以内（1端子当たり）

注意 ウェーブ・ソルダーリングは端子のみとし、噴流半田が直接本体に接触しないようご注意ください。



## — CMOSデバイスの一般的注意事項 —

## ① 静電気対策 (MOS全般)

注意 MOSデバイス取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。

MOSデバイスは強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、NECが出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジン・ケース、または導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。

また、MOSデバイスを実装したボードについても同様の扱いをしてください。

## ② 未使用入力の処理 (CMOS特有)

注意 CMOSデバイスの入力レベルは固定してください。

バイポーラやNMOSのデバイスと異なり、CMOSデバイスの入力に何も接続しない状態で動作させると、ノイズなどに起因する中間レベル入力が生じ、内部で貫通電流が流れて誤動作を引き起こす恐れがあります。プルアップかプルダウンによって入力レベルを固定してください。また、未使用端子が出力となる可能性 (タイミングは規定しません) を考慮すると、個別に抵抗を介してV<sub>DD</sub>またはGNDに接続することが有効です。

資料中に「未使用端子の処理」について記載のある製品については、その内容を守ってください。

## ③ 初期化以前の状態 (MOS全般)

注意 電源投入時、MOSデバイスの初期状態は不定です。

分子レベルのイオン注入量等で特性が決定するため、初期状態は製造工程の管理外です。電源投入時の端子の出力状態や入出力設定、レジスタ内容などは保証しておりません。ただし、リセット動作やモード設定で定義している項目については、これらの動作ののちに保証の対象となります。

リセット機能を持つデバイスの電源投入後は、まずリセット動作を実行してください。

本製品が外国為替および外国貿易管理法の規定による戦略物資等（または役務）に該当するか否かは、ユーザ（仕様を決定した者）が判定してください。

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。  
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器  
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等  
 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111 (大代表)
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (NEC中部ビル)	名古屋 (052)222-2170
半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208
北海道支社 札幌 東北支社 仙台 岩手支店 盛岡 山形支店 山形 郡山支店 郡山 いわき支店 いわき 長岡支店 長岡 土浦支店 土浦 水戸支店 水戸 神奈川支社 横浜 群馬支店 高崎 太田支店 太田 宇都宮支店 宇都宮	(011)231-0161 (022)261-5511 (0196)51-4344 (0236)23-5511 (0249)23-5511 (0246)21-5511 (0256)36-2155 (0298)23-6161 (0292)26-1717 (045)324-5511 (0273)26-1255 (0276)46-4011 (0266)21-2261	小山支店 小山 (0285)24-5011 長野支社 長野 (0262)35-1444 松本支店 松本 (0263)35-1666 上諏訪支店 諏訪 (0266)53-5350 甲府支店 甲府 (0552)24-4141 埼玉支社 大宮 (048)641-1411 立川支店 立川 (0425)26-5981 千葉支社 千葉 (043)238-8116 静岡支店 静岡 (054)265-2211 沼津支店 沼津 (0559)63-4455 浜松支店 浜松 (053)452-2711 北陸支店 金沢 (0762)23-1621 福井支店 福井 (0776)22-1866
富山支店 富山 三重支店 津 京都支社 京都 神戸支店 神戸 中国支社 広島 鳥取支店 鳥取 岡山支店 岡山 四国支店 高松 新居浜支店 新居浜 松山支店 松山 九州支社 福岡 北九州支店 北九州	(0764)31-8461 (0592)25-7341 (075)344-7824 (078)333-3854 (082)242-5504 (0857)27-5311 (086)225-4455 (0878)36-1200 (0897)32-5001 (0899)45-4111 (092)271-7700 (093)541-2887	

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 メモリ技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目404番地	川崎 (044)548-8892	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお問い合わせします)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (NEC中部ビル)	名古屋 (052)222-2125	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3363	